

Silicon Diode

1N4001

50V / 1A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

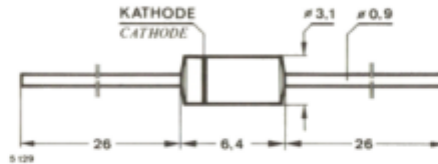
1 N 4001 bis to 1 N 4007

**Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes**

Anwendungen: Gleichrichter

Applications: Rectifier

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Kunststoffgehäuse
Plastic case
≈ JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,5 g

**Absolute Grenzwerte
Absolute maximum ratings**

Sperrspannung, periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, repetitive peak reverse voltage

1 N 4001	$U_R = U_{RRM}$	50	V
1 N 4002	$U_R = U_{RRM}$	100	V
1 N 4003	$U_R = U_{RRM}$	200	V
1 N 4004	$U_R = U_{RRM}$	400	V
1 N 4005	$U_R = U_{RRM}$	600	V
1 N 4006	$U_R = U_{RRM}$	800	V
1 N 4007	$U_R = U_{RRM}$	1000	V

Stoßdurchlaßstrom
Surge forward current

I_{FSM}	50	A
-----------	----	---

Sinushalbwellen, $f = 50$ Hz
Sine wave

Durchlaßstrom, Mittelwert
Average forward current

I_{FAV}	1	A
-----------	---	---

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

t_j	175	°C
-------	-----	----

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

t_{stg}	-65...+175	°C
-----------	------------	----

**Wärmewiderstand
Thermal resistance**

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
 $l = 25$ mm, $t_L =$ konstant
constant

	Min.	Typ.	Max.
R_{thJA}			85 °C/W

1 N 4001 bis to 1 N 4007

Kenngrößen
Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 1\text{ A}$ $U_F^{*)}$ 1,1 V

Durchlaßspannung, Mittelwert
Average forward voltage

$I_{FAV} = 1\text{ A}, l = 25\text{ mm}, t_L = 75^\circ\text{C}$ $U_{FAV}^{**)}$ 0,8 V

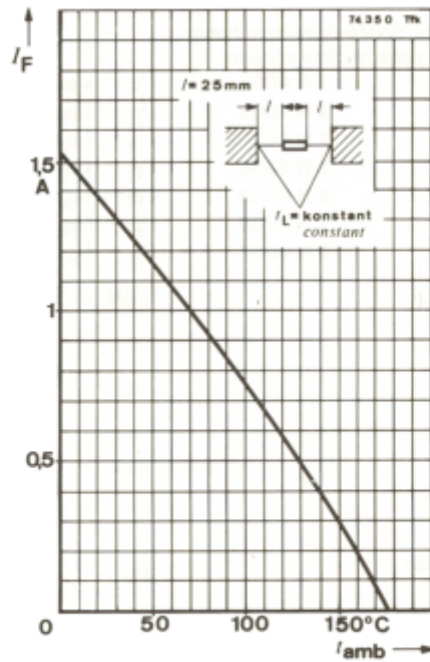
Sperrstrom
Reverse current

$U_R = U_{RRM}$ $I_R^{*)}$ 10 μA

$U_R = U_{RRM}, t_j = 100^\circ\text{C}$ $I_R^{**)}$ 50 μA

Sperrstrom, Mittelwert
Average reverse current

$U_R = U_{RRM}, I_{FAV} = 1\text{ A}, l = 25\text{ mm}, t_L = 75^\circ\text{C}$ I_{RAV} 30 μA



*) AQL = 0,85%

***) AQL = 2,5%